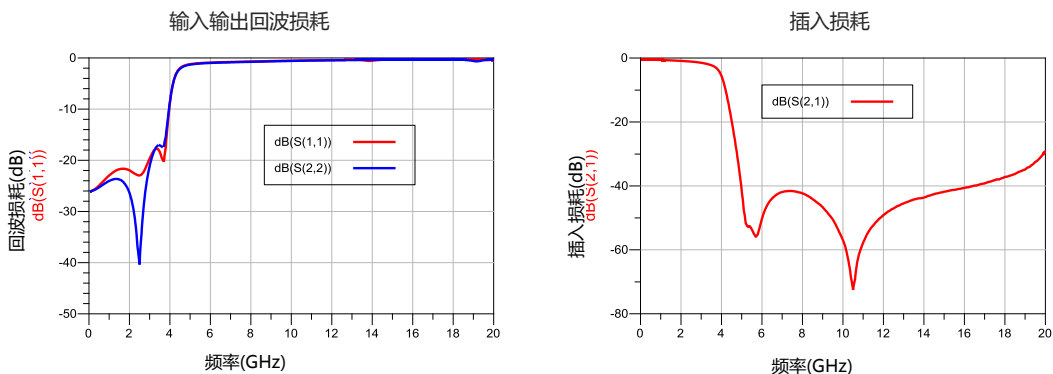


性能特点：

- 通带频率：DC-3GHz
- 通带损耗： $\leq 1.6\text{dB}$
- 阻带衰减： $\geq 20\text{dB}@4.6\text{GHz}$ ， $\geq 40\text{dB}@5.0\text{GHz}$
- 回波损耗： $\geq 20\text{dB}$
- 芯片尺寸： $1.0 \times 0.70\text{mm} \times 0.1\text{mm}$

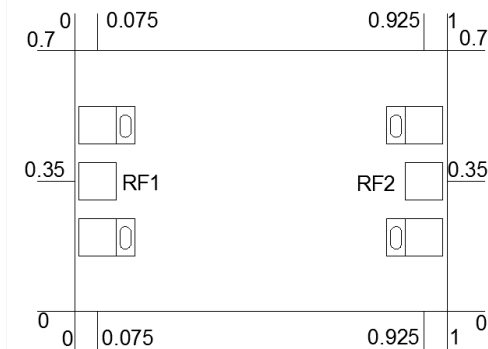
产品简介：

HH-LF0003 是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点，广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现，性能不受外部盒体影响，使用简单方便。芯片尺寸 $1.0\text{mm} \times 0.70\text{mm} \times 0.1\text{mm}$ 。

典型曲线：（ $T_A=25^\circ\text{C}$ ）


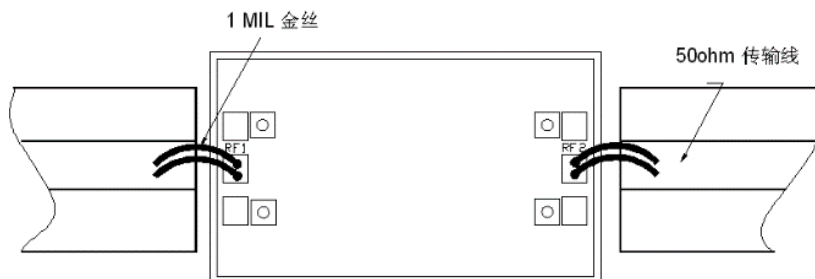
使用限制参数：（超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。）

最大输入功率	33 dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

芯片实物尺寸图：（单位 mm）

说明：

1. 单位：毫米，公差： $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金，压点尺寸： $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

芯片建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。